

تأثیر میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم (شدت ۵ میلی تسلا و فرکانس ۵۰ هرتز) بر تثبیت و فراخوانی حافظه در موشهای صحرایی نر

شیرین بیری (PhD)^{۱*}، فریا میرزایی باویل (MSc)^۱، هادی ابراهیمی (MSc)^۱

۱- مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت: ۸۸/۵/۵، اصلاح: ۸۸/۷/۸، پذیرش: ۸۸/۱۲/۱۹

خلاصه

سابقه و هدف: خطوط نیرو و تجهیزات برقی خانگی نظیر تلویزیون، کامپیوتر، سشوار از خود میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم ساطع می کنند که می توانند موجب آسیب شوند. باتوجه به افزایش قرارگیری در معرض چنین میدانهای مغناطیسی در سالهای اخیر و اثرات این میدانها بر تشکیل حافظه، این مطالعه به منظور تاثیر این نوع میدانها بر تثبیت و فراخوانی حافظه در موشهای صحرایی نر انجام شد.

مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی ۹۰ موش صحرایی نر با نژاد ویستار که در ۹ گروه تقسیم بندی شدند، انجام گردید. گروه کنترل در دستگاه شاتل باکس (دستگاه آموزش اجتنابی غیر فعال) آموزش دیدند، گروه شم، پس از آموزش بلافاصله به مدت ۴ ساعت در دستگاه مولد میدان الکترومغناطیسی خاموش قرار داده شدند. چهار گروه تست تثبیت حافظه بعد از آموزش به ترتیب به مدت ۸ و ۶ و ۴ و ۱ ساعت در دستگاه مولد میدان قرار داده شدند. شدت میدان مغناطیسی که موشها در معرض آن قرار گرفتند، معادل ۵ میلی تسلا و فرکانس ۵۰ هرتز بود. سه گروه تست فراخوانی حافظه پس از آموزش و تست به ترتیب به مدت ۵ و ۴ و ۳ روز متوالی (به مدت ۴ ساعت) در دستگاه مولد میدان قرار گرفتند. همه گروهها ۲۴ ساعت بعد مجدداً تست شدند. در تمامی گروهها مدت زمانی که طول می کشید تا حیوان از ناحیه روشن شاتل باکس به محفظه تاریک وارد شود به عنوان زمان تاخیر اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفتند.

یافته ها: در چهار گروه تست تثبیت حافظه بین گروه اول که یک ساعت در میدان قرار گرفته بودند (485 ± 76 ثانیه) و گروه کنترل (583 ± 17 ثانیه) اختلاف معنی داری وجود نداشت. درحالی که در سه گروه دیگر که به ترتیب ۸ و ۶ و ۴ ساعت در میدان قرار گرفته بودند (303 ± 17 ، 294 ± 17 و 191 ± 72 ثانیه) اختلاف با گروه کنترل معنی دار بود ($p < 0.05$). بین گروه شم ($541/8 \pm 58$ ثانیه) باگروهی که به مدت ۴ ساعت در میدان الکترو مغناطیسی قرار داده شده بودند (303 ± 17 ثانیه) اختلاف معنی دار بود ($p < 0.05$). نتایج بدست آمده از سه گروه تست فراخوانی حافظه نشان داد که بین نتایج قبل (572 ± 37 و $580 \pm 54/8$ و $585 \pm 51/4$ ثانیه) و بعد از قرارگیری مزمن در میدان به ترتیب ۵ و ۴ و ۳ روز متوالی (563 ± 42 ، $545/2 \pm 54/8$ و $548/6 \pm 51/4$ ثانیه) اختلاف معنی داری نداشت.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که قرارگیری در معرض میدان مغناطیسی با فرکانس کم به صورت حاد قادر به جلوگیری از تثبیت حافظه است اما تاثیری بر فراخوانی حافظه ندارد.

واژه های کلیدی: میدان مغناطیسی، حافظه، فراخوانی، موش صحرایی.

مقدمه

می توانند موجب آسیب شوند، مانند میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس کم که غالباً با فرآیند تولید و انتقال و استعمال الکتریسته در ارتباط هستند. خطوط نیرو و تجهیزات برقی خانگی نظیر تلویزیون، کامپیوتر، سشوار و ... از

کاربرد روز افزون میدانهای الکترومغناطیسی موجب شده که توجه به اثرات سوء این میدان بیش از پیش مدنظر قرارگیرد. تجهیزات و دستگاههای گوناگونی که مولد میدان الکترو مغناطیسی بوده و در زندگی روزمره کاربرد دارند،

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره ۸۱/۴۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد.
* مسئول مقاله:

e-mail: shirine46@yahoo.com

آدرس: تبریز، خیابان دانشگاه، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، آزمایشگاه فیزیولوژی، تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۶۴۶۴

درجه سانتیگراد بوده و سیکل نور و تاریکی ۱۲ ساعت، رعایت گردید. برای آموزش موشها از دستگاه آموزش اجتنابی غیر فعال (Shuttle Box) استفاده شد. محفظه این دستگاه از دو اتاقک مجزا تشکیل شده که توسط یک در گیوتینی به ابعاد ۸×۸ سانتی متر از هم جدا می‌شوند، در داخل درب یک گیرنده مادون قرمز تعبیه شده که عبور موش از حد فاصل درب را به سیستم اطلاع داده و سبب قطع زمان سنخ عبور می‌گردد. در کف هر کدام از این دو اتاقک میله‌هایی به قطر ۳ میلی متر با فاصله ۱ سانتی متر از هم قرار دارد. ابعاد هر اتاقک ۳۰×۲۱×۲۰ سانتی متر بوده و در بالای آن یک لامپ ۱۲ ولت، ۱۰ وات وجود دارد. موشها یکساعت قبل از آموزش درب محفظه روشن قرار داده شدند و ۱۰ ثانیه بعد درب بین دو اتاقک محفظه باز شد. بلافاصله بعد از ورود حیوان به محفظه تاریک در بسته شد و حیوان از محفظه تاریک خارج و به قفس برگردانده شد. این عمل ۳۰ دقیقه بعد تکرار شد. بعد از بار دوم سازش یافتن، آموزش اجتنابی غیر فعال صورت گرفت، به این ترتیب که این بار بعد از قرار گیری موش در محفظه روشن درب بین دو قسمت محفظه باز شد و بلافاصله بعد از ورود موش به قسمت تاریک، درب بین دو قسمت بسته شد و شوک الکتریکی با فرکانس ۵۰ هرتز و شدت ۰/۶۵ میلی آمپر برای مدت ۵ ثانیه اعمال گردید. بعد از ۱۰ ثانیه موش را از قسمت تاریک گرفته و به قفس برگردانده شد. جهت اطمینان از اکتساب آموزش اجتنابی غیر فعال دو دقیقه بعد مجدداً آموزش تکرار شد. عدم ورود حیوان به قسمت تاریک در مدت ۱۲۰ ثانیه یادگیری مثبت در نظر گرفته شد، در غیر این صورت حیوان تا یادگیری کامل شوک مجدد داده شد. تست به خاطر آوری (تثبیت حافظه) بیست و چهار ساعت پس از آموزش انجام گرفت. موش مورد آزمایش در اتاقک روشن قرار گرفته و ۵ ثانیه بعد درب بین دو اتاقک باز شد. زمانیکه طول می‌کشید تا حیوان وارد قسمت تاریک شود، به عنوان زمان تاخیر (Retention Latency) یادداشت گردید. به عنوان مثال موشی که بعد از ۲۰۰ ثانیه وارد بخش تاریک می‌شد زمان تاخیر معادل ۲۰۰ ثانیه داشت (۱۳ و ۱۴).

دستگاه مولد میدان مغناطیسی مورد استفاده براساس تتوری پیچ هلمهولتز در آزمایشگاه فیزیولوژی ساخته شده است (۱۶ و ۱۵ و ۸). قسمت مولد میدان این دستگاه از دو حلقه سیم پیچ به شعاع ۳۵ سانتیمتر که به فاصله ۳۵ سانتیمتر بصورت هم محور قرار گرفته اند تشکیل یافته، جنس حلقه های حامل سیم پیچ از چوب بوده و هیچ گونه فلزی در آن بکار نرفته است و توسط سه پایه چوبی که روی صفحه ای از جنس ام دی اف تعبیه شده اند، به فاصله مذکور از هم قرار گرفته اند. جهت تولید میدان یکنواخت در کل این مجموعه از هیچ قطعه فلزی استفاده نشده است. در فضای بین این دو حلقه در حجمی به ارتفاع و شعاع ۳۰ سانتی متر میدان یکنواختی ایجاد می شود. شدت میدان مغناطیسی که موشها در معرض آن قرار گرفتند، معادل ۵ میلی تسلا و فرکانس ۵۰ هرتز بود. برای بررسی و اطمینان از شدت میدان از دستگاه گوس متر (تسلا متر) مدل bell-4180 و triple-Axis Gauss meter استفاده شد (۱۷).

گروه کنترل بدون قرار گرفتن در میدان الکترومغناطیسی، در دستگاه شاتل باکس (دستگاه آموزش اجتنابی غیر فعال) آموزش دیده و ۲۴ ساعت بعد تست شدند. گروه شم، ابتدا در شاتل باکس آموزش دیده بلافاصله به مدت ۴ ساعت در دستگاه مولد میدان الکترومغناطیسی خاموش قرار داده شد و ۲۴ ساعت بعد تست یادگیری بر روی آنها انجام گرفت. چهار گروه تست تثبیت حافظه بعد از آموزش در شاتل باکس بلافاصله در دستگاه مولد میدان (فرکانس ۵۰ هرتز و شدت ۵

خود میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم (Extremely Low Frequency Magnetic Field=ELF-MF) ساطع می کنند (۱). البته برخی از این نوع میدانها مانند تجهیزات به کار رفته در درمان درد، تحریک رشد استخوان و اندازه گیری بیوامپدانس در پزشکی کاربرد درمانی دارند (۲). میدانهای مغناطیسی از نظر توانایی در یونیزه کردن یا نکردن یک اتم یا مولکول به دو نوع یونیزان و غیر یونیزان تقسیم می شود. میدانهای غیر یونیزان خود بر اساس فرکانس به ۴ گروه، Static: فرکانس صفر، Extremely Low Frequency: فرکانس صفر تا ۳۰۰ هرتز، Intermediate Frequency: فرکانس ۳۰۰ تا ۱۰۰ کیلو هرتز، Radio Frequency: ۱۰۰ کیلو هرتز تا ۳۰۰ گیگا هرتز تقسیم می شوند (۲).

ELF-MF می تواند در سیستم بیولوژیکی موجودات زنده مانند حشرات، چوندگان و انسان اختلال ایجاد کند که موجب تغییرات بیولوژیکی در پتانسیل غشای سلول و اختلال در انتقال یونی از طریق غشای سلولی می شود (۳-۵). این تغییرات جزئی در پتانسیل غشا خود می تواند در فرآیند سیگنالینگ در مغز نیز تاثیر گذار باشد (۶). مطالعات اپیدمیولوژیکی یک ارتباط احتمالی میان قرارگیری مزمن در معرض ELF-MF و اختلالات جسمانی، مانند لوسمی، سرطان مغز، سینه، کلیه و بیماریهای قلبی و عروقی را در انسان مطرح می کنند (۷). مطالعات نشان داده که قرار گیری در ELF-MF موجب اختلال در عملکرد نورونها، تغییر ماهیت نوروترانسمیترها و اختلال رفتاری در حیوان و نفوذپذیری سد خونی مغزی و عروق می گردد (۸ و ۹).

نتایج حاصل از مطالعات انجام گرفته در رابطه با تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی بر روی حافظه تا حدودی متناقض بوده و نیاز به بررسی بیشتر دارد (۱۰). قرارگیری موشهای صحرایی در معرض میدان مغناطیسی باعث بروز فراموشی قلبی (Retrograde Amnesia) در یادگیری اجتنابی غیر فعال می شود (۱۱) البته برخی مطالعات مبنی بر عدم تاثیر میدان های الکترومغناطیسی در حافظه می باشد (۱۲). احتمالاً شدت میدان مغناطیسی و مدت زمان قرار گیری در معرض میدان، منجر به نتایج مختلف، تثبیت حافظه و مراحل آن، فراخوانی حافظه، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت می گردد. از آنجاییکه مطالعات انجام شده بر روی فراخوانی حافظه بسیار ناچیز است بنابراین انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه جهت تعریف معیارهای خاص لازم به نظر می رسد، لذا این مطالعه به منظور بررسی اثرات میدان الکترومغناطیسی با شدت و فرکانس معین بر تثبیت و فراخوانی حافظه در شرایط مختلف انجام شد تا با مقایسه نتایج بتوان با ارائه راهکارهای مناسب اثرات سوء میدانهای الکترومغناطیسی را به حداقل رساند.

مواد و روشها

این مطالعه تجربی بر روی ۹۰ موش سفید صحرایی نر نژاد ویستار با متوسط وزنی 25 ± 25 g و سن ۳ الی ۴ ماه که از حیوانخانه مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه عوم پزشکی تبریز تهیه شده بودند، انجام شد. موشها به طور تصادفی به ۹ گروه ده تایی شامل یک گروه کنترل، یک گروه شم، ۴ گروه بررسی تثبیت حافظه و ۳ گروه بررسی فراخوانی حافظه تقسیم شدند. در طول انجام آزمایشات موشها در محل حیوان خانه مرکز به صورت ۵ سر در هر قفس نگهداری شده و دسترسی آزادانه به آب و غذا داشتند. دمای حیوانخانه 22 ± 1

زمان تاخیر در گروه شم نیز در مقایسه با گروهی که ۴ ساعت در میدان قرار گرفته بودند کاهش معنی داری نشان نداد.

نتایج بدست آمده از سه گروه تست فراخوانی حافظه که بعد از آموزش و تست پرتیب ۳، ۴ و ۵ روز و هر روز به مدت ۴ ساعت در میدان الکترومغناطیسی قرار گرفته بودند، نشان داد که بین نتایج قبل از قرارگیری در میدان (به ترتیب 572 ± 27 ، 541 ± 58 ، 514 ± 85 ثانیه) و بعد از قرارگیری مزمن در میدان (563 ± 42 ، 545 ± 48 ، 515 ± 52 ثانیه) اختلاف معنی دار نبود.

بحث و نتیجه گیری

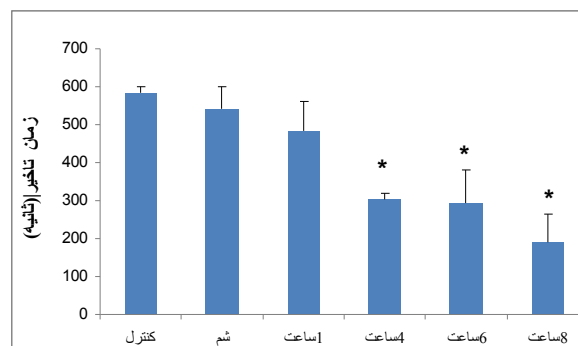
نتایج مطالعه نشان داد که میدان مغناطیسی با فرکانس ۵۰ هرتز و شدت ۵ میلی تسلا در مدت یکساعت تأثیری بر روند تثبیت حافظه ندارد در حالیکه قرارگیری در همین میدان برای مدت ۴ ساعت و یا بیشتر از آن تثبیت حافظه را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین نتایج بیانگر عدم تأثیر میدان الکترو مغناطیسی بر فراخوانی حافظه می باشد. شواهد بدست آمده از آزمایشات مختلف حاکی از تأثیر میدان مغناطیسی بر روندهای بیولوژیک بدن موجودات زنده است (۳ و ۴). گزارش شده که میدانهای مغناطیسی با فرکانس پایین، به خصوص میدانهای مغناطیسی ناشی از فرکانسهای صنعتی ۵۰ و ۶۰ هرتز قادر به اعمال نفوذ در عملکرد سیستم عصبی مرکزی می باشند، احتمالاً "آستانه حساسیت به محرکهای حسی را کاهش می دهند، فعالیت الکتریکی مغز را تغییر داده، روند اکتساب مهارتها و ذخیره اطلاعات و فراخوانی آن را دچار اختلال می نمایند (۱۸ و ۱۶). براساس یک گزارش قرار گیری داوطلبین جوان مونث و مذکر به مدت ۱ ساعت در معرض میدان مغناطیسی خیلی ضعیف با فرکانس ۵۰ هرتز و شدت ۱ میلی تسلا توام با 45dB SPL noise موجب کاهش فوری در کارایی شناختی در تمرکز، درک و کارایی حافظه گردید (۱۹) که با نتیجه بدست آمده از این تحقیق مغایر است چون میدان مغناطیسی در طی یکساعت تأثیری بر تثبیت حافظه اجتنابی نداشت. در تحقیق دیگری که اثر میدانهای مغناطیسی با شدت ۷/۵ میکروتسلا و ۷/۵ میلی تسلا بلافاصله قبل از تست حیوان مورد بررسی قرار گرفته بود (با مدت زمان قرارگیری ۴۵ دقیقه در میدان مغناطیسی) نتایج نشان داد که در مجموع تأثیر معنی داری بر تست دقت انتخاب توسط افراد مورد مطالعه نداشت (۲۰) که با نتایج حاصل از تحقیق انجام شده اخیر همسو بود. البته مطالعه ما همچنین نشان داد در زمان تاخیر گروههایی که برای مدت ۴، ۶ و ۸ ساعت در معرض میدان قرار گرفتند افزایش معنی داری وجود دارد. در یک تحقیق که اخیراً صورت گرفت، قرارگیری موشها برای مدت چهار هفته هر روز به طور مزمن در معرض میدان مغناطیسی با فرکانس کم (50Hz, 2mT) برای مدت ۱ و ۴ ساعت موجب کاهش زمان لازم برای یافتن سکوکی پنهان در ماز آبی شد (بررسی حافظه فضایی) (۲۱). در حالیکه گزارشهای دیگری حاکی از آسیب حافظه فضایی بر اثر قرارگیری حاد در معرض میدان می باشد (۲۳ و ۲۲). با اینکه مکانیسم تداخل امواج میدان مغناطیسی با روندهای مربوط به تثبیت حافظه کاملاً مشخص نیست اما برخی از تحقیقات انجام یافته حاکی از این است که این میدانها بر میزان نوروترانسمیترها در نواحی مختلف سیستم عصبی مرکزی موثرند (۸). اندازه گیری میزان نوروترانسمیترهایی نظیر سروتونین و دوپامین و متابولیتهای آنها حاکی از این است که قرار گیری مزمن در معرض میدان مغناطیسی برای مدت ۷ روز

میلی تسلا) به ترتیب به مدت ۱، ۴، ۶ و ۸ ساعت قرار داده شدند. ۲۴ ساعت بعد تست یادگیری بر روی آنها انجام گرفت. سه گروه تست فراخوانی حافظه ابتدا در شاتل باکس آموزش دیده سپس ۲۴ ساعت بعد تست روی آنها انجام شد. بعد از تست سه گروه به ترتیب به مدت ۳، ۴ و ۵ روز متوالی و هر روز به مدت ۴ ساعت در دستگاه مولد میدان (فرکانس ۵۰ هرتز و شدت ۵ میلی تسلا) قرار گرفتند و ۲۴ ساعت بعد مجدداً تست شدند.

در تمامی گروهها مدت زمانی که طول می کشید تا حیوان از ناحیه روشن شاتل باکس به محفظه تاریک وارد شود به عنوان زمان تاخیر (retention latency) بر حسب ثانیه اندازه گیری شد و با یکدیگر مقایسه شدند. گروهها با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه، Paired t- و Tukey test مقایسه شده و $p < 0.05$ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

قرارگیری موشها در میدان الکترومغناطیسی خاموش (گروه شم، 541 ± 58 ثانیه) در مقایسه با گروه کنترل (583 ± 17 ثانیه) تأثیر معنی داری بر زمان تاخیر نداشت ($p < 0.05$). زمان تاخیر در موشهای گروه کنترل در مقایسه با موشهایی که بلافاصله بعد از آموزش برای مدت ۱ ساعت در معرض میدان قرار گرفتند (485 ± 76 ثانیه) تغییر معنی داری نیافت، اما میانگین زمان تاخیر برای موش هایی که مدت ۴ ساعت (303 ± 17 ثانیه) در معرض میدان قرار گرفته بودند در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد ($p < 0.05$) (نمودار ۱).



نمودار شماره ۱. مقایسه زمان تاخیر بر حسب ثانیه مابین گروه کنترل و گروههایی که برای مدت زمان های متفاوت در معرض میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم قرار گرفتند. مقادیر بر حسب میانگین $\pm$ خطای استاندارد می باشد. $p < 0.05$ معنی دار در نظر گرفته شده است. * معنی دار نسبت به گروه کنترل

افزایش زمان قرار گیری در میدان از ۴ ساعت به ۶ ساعت زمان تاخیر را تا حدودی کاهش داد (294 ± 87 ثانیه). این کاهش در مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود ($p < 0.05$)، اما کاهش ایجاد شده مابین این دو گروه معنی دار نبود. گروه بعدی که برای مدت ۸ ساعت بلافاصله بعد از آموزش در معرض میدان مغناطیسی بودند (191 ± 72 ثانیه) در مقایسه با گروه کنترل کاهش قابل توجهی در زمان تاخیر نشان دادند ($p < 0.05$). در صورتی که در مقایسه با گروههایی که ۶ و ۴ ساعت در معرض میدان قرار گرفته بودند زمان تاخیر تغییر معنی داری نیافت.

آسیب سلولی و فرآیند دژنره شدن سلولهای عصبی در مغز شود (۱۸). سیستم کولینرژیک مغز نیز نقش مهمی در یادگیری و حافظه دارد و بر اساس یک تحقیق قرارگیری در معرض میدان مغناطیسی موجب کاهش فعالیت این سیستم در ناحیه فرونتال و هیپوکامپ می شود (۲۸). بنابراین احتمالاً اختلال در تثبیت حافظه ناشی از میدان می تواند به دلیل کاهش فعالیت سیستم کولینرژیک باشد و تبدیل حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت همراه با تولید RNA و سنتز پروتئین می باشد (۲۹). گزارش شده که میدان های مغناطیسی بر بیان ژنی و ساختمان سه بعدی پروتئین ها و DNA اثر می گذارند، پس تخریب حافظه توسط میدان مغناطیسی می تواند ناشی از اختلال در بیان ژنی و سنتز پروتئین باشد (۳۰ و ۳۱).

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مبنی بر تاثیر میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین و شدت ۵ میلی تسلا بر کاهش زمان تاخیر در یادگیری از نوع اجتنابی غیر فعال و عدم تاثیر بر فراخوانی حافظه و با عنایت به شواهد موجود در مورد تاثیر این نوع میدانها بر نوروترانسمیترها، رسپتورها، یونهای نظیر کلسیم و نیز فعالیت الکتریکی مغز، پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتر در جنبه های مولکولی تاثیرات این میدان ها بر سیستم عصبی در راستای مشخص شدن علل تفاوت مشاهده شده در نتایج در شدت های مختلف میدان، مدت زمان قرارگیری در میدان و انواع مختلف یادگیری انجام گیرد.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از مسوولین محترم مرکز تحقیقات کاربردی- داروئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که هزینه انجام این تحقیق را فراهم نموده اند و همچنین از همکاری های صمیمانه پرسنل محترم آزمایشگاه فیزیولوژی قدردانی می گردد.

متابولیسم سروتونین را تحت تاثیر قرار می دهد (۲۴). به این ترتیب می توان گفت احتمالاً اثرات متناقض میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس کم بر فرآیند یادگیری و حافظه ناشی از تاثیر بر عملکرد نوروترانسمیترهای مختلف می باشد و تحقیقات بیشتر در این زمینه جهت رفع ابهامات موجود مورد نیاز است. بر اساس یک گزارش میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم میزان کلسیم داخل سلولی را در بافت عصبی افزایش داده و فعالیت پروتئین کیناز C و پروتئین کیناز وابسته به کلسیم- کالمودولین را در برشهای بافتی تهیه شده از هیپوکامپ تغییر داده است (۲۵). از آنجایی که رسپتورهای NMDA(N-Methyl -D-Aspartate) که در جریان تشکیل حافظه دخالت دارند با افزایش کلسیم داخل سلولی غیر فعال می شوند که این حالت می تواند زمانی که حیوان در معرض ELF-MF قرار می گیرد، به وجود آید (۱۶). همچنین براساس برخی مطالعات گزارش شده که میدان الکترو مغناطیسی با فرکانس پایین قادر به فعال سازی سیستم ایپوتید آندوژن می باشد که نقش تعدیل کننده در رفتار دارد و نیز موجب اختلال در سیرکادین ریتم، الگوی خواب و کاهش اثرات مسکن ها در انسان می شود (۲۶ و ۱۶).

میدان مغناطیسی در فعالیت الکتریکی مغز نیز اختلال ایجاد می نماید. نتایج برخی مطالعات تأیید کننده اثر میدان مغناطیسی بر فعالیت الکتریکی مغز می باشد (۲۷ و ۱۹). همچنین می تواند موجب تغییرات بیولوژیکی در پتانسیل غشای سلول و اختلال در انتقال یونی از طریق غشای سلولی شود (۵). این تغییرات جزئی در پتانسیل غشا خود می تواند در فرآیند سیگنالینگ در مغز نیز تاثیر گذار باشد (۶). پس احتمالاً یکی دیگر از مکانیسم هایی که میدان مغناطیسی از طریق آن بر تثبیت حافظه تاثیر می گذارد می تواند تغییر فعالیت الکتریکی سلولهای سیستم عصبی مرکزی باشد. در واقع مکانیسم های که میدان مغناطیسی توسط آن موجب تاثیر بر روند تثبیت حافظه و اختلال در آن می شود کاملاً واضح نیست. مطالعات تجربی نشان داده اند که استرس اکسیداتیو ممکن است موجب

Effect of Extremely Low-Frequency Electromagnetic Field (50 Hz, 5mT) on Memory Consolidation and Retrieval in Male Rats

Sh. Babri (PhD)^{1*}, F. Mirzaei Babil (MSc)¹, H. Ebrahimi (MSc)¹

1. Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

J Babol Univ Med Sci;12(3); Aug-Sep 2010

Received: Jul 27th 2009, Revised: Sep 30th 2009, Accepted: Mar 10th 2010.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Power lines and household electrical appliances (TV, computer, and hairdryer) emit extremely low-frequency magnetic field (ELF-MF) that can be damaging. As the exposure of these MF is increasing now days and important effect of MF on memory formation, in this study effects of these fields on memory consolidation and retrieval in male rats were examined.

METHODS: In this experimental study, 90 male Wistar rats were divided into nine groups. Control group was trained in shuttle box (passive avoidance box). Sham group was put in turn off MF immediately after training for 4 hrs. Four test groups of memory consolidation after training were exposed on MF for 1, 4, 6 and 8 hrs respectively. The rats were exposed on MF (50 Hz, 5mT). Three test groups of memory retrieval after testing, were exposed on MF (4 hrs) for 3, 4 and 5 days respectively and were tested again 24 hrs after the last exposure. In all of groups, the time of entrance from light to dark area was measured in shuttle box as "retention latency" and compared.

FINDINGS: In 4 test groups of memory consolidation, between first group that was exposed on MF for 1 hr (485 ± 76 s), and control group (583 ± 17 s) difference was not significant ($p < 0.05$) while in other groups that were exposed on MF for 4, 6, 8 hrs (303 ± 17 , 294 ± 87 , 191 ± 72 s) difference was significant ($p < 0.05$). Between sham group (541 ± 58) and test group that was exposed on MF for 4 hrs (303 ± 17) difference was significant ($p < 0.05$). The results of 3 test groups of memory retrieval showed that there was not any significant difference between before (572 ± 37 , 580 ± 54.8 and 585 ± 51.4) and after (563 ± 42 , 545.2 ± 54.8 and 548.6 ± 51.4) exposing for 3, 4 and 5 days.

CONCLUSION: Acute exposure on ELF-MF can acutely prevent from memory consolidation but had no effect on memory retrieval.

KEY WORDS: *Electromagnetic field, Memory, Retrieval, Rat.*

*Corresponding Author;

Address: Physiology Laboratory, Drug Applied Research Center, Daneshgah St., Tabriz, Iran

Tel: +98 411 3364664

E-mail: shirine46@yahoo.com

References

1. Jelenković A, Janać B, Pesić V, Jovanović DM, Vasiljević I, Prolić Z. Effects of extremely low-frequency magnetic field in the brain of rats. *Brain Res Bull* 2006;68(5):355-60.
2. Hartwig V, Giovannetti G, Vanello N, Lombardi M, Landini L, Simi S. Biological effects and safety in magnetic resonance imaging: a Review. *Int J Environ Res Public Health* 2009;6(6):1778-98.
3. Prolic Z, Jovanovic R, Konjevic G, Janac B. Behavioral differences of the insect *Morimus funereus* (Coleoptera, Cerambycidae) exposed to an extremely low frequency magnetic field. *Electromagn Biol Med* 2003; 22(1):63-73.
4. Pesić V, Janać B, Jelenković A, Vorobyov V, Prolić Z. Non-linearity in combined effects of ELF magnetic field and amphetamine on motor activity in rats. *Behav Brain Res* 2004;150(1-2):223-7.
5. Berg H. Electrostimulation of cell metabolism by low frequency electric and electromagnetic fields. *Bioelectrochem Bioenerg* 1993;31:1-25.
6. Mathie A, Kennard LE, Veale EL. Neuronal ion channels and their sensitivity to extremely low frequency weak electric field. *Radiat Prot Dosimetry* 2003;106(4): 311-316.
7. Labreche F, Goldberg MS, Valois MF, et al. Occupational exposures to extremely low frequency magnetic fields and postmenopausal breast cancer. *Am J Ind Med* 2003;44(6):643-52.
8. Pazur A. Characterisation of weak magnetic field effects in an aqueous glutamic acid solution by nonlinear dielectric spectroscopy and voltammetry. *Biomagn Res Technol* 2004;2(1):8.
9. Duzel E. When, where, what: the electromagnetic contribution to the www of brain activity during recognition. *Acta Psychol Amst* 2000;105(2-3):195-210.
10. Vazquez-Garcia M, Elias-Vinas D, Reyes-Guerrero G, Dominguez-Gonzalez A, Verdugo-Diaz L, Guevara-Guzman R. Exposure to extremely low-frequency electromagnetic improve social recognition in male rats. *Physiol Behav* 2004;82(4):685-90.
11. Krylova IN, Dukhanin AS, Il'in AB, et al. The effect of ultrahigh-frequency electromagnetic radiation on learning and memory processes. *Biull Eksp Biol Med* 1994;14(11):483-4.
12. Sienkiwicz ZJ, Bartram R, Haylock RG, Saunders RD. Single, brief exposure to a 50 Hz magnetic field does not affect the performance of an object recognition task in adult mice. *Bioelectromagnetics* 2001;22(1):19-26.
13. Babri S, Gholamipour Badie H, Khamenei S, Ordikhani Seyedlar M. Intrahippocampal insulin improves memory in a passive avoidance task in male wistar rats. *Brain Cogn* 2007;64(1):86-91.
14. Rick JT, Murphy MP, Ivy GO, Milgram NW. Short intertrial intervals impair water maze performance in old fischer 344 rats. *J Gerontol A Bio Sci Med Sci* 1996;51(4):253-60.
15. Mostafa RM, Mostafa YM, Ennaceur A. Effects of exposure to extremely low-frequency magnetic field of 2 G intensity on memory and corticosterone level in rats. *Physiol Behav* 2002;76(4-5):589-95.
16. Manikonda PK, Rajendra P, Devendranath D, et al. Influence of extremely low frequency magnetic fields on Ca²⁺ signaling and NMDA receptor functions in rat hippocampus. *Neurosci Lett* 2007;413(2):145-9.
17. Kaune WT. Introduction to power-frequency electric and magnetic fields. *Environ Health Perspect* 1999;101(Suppl 4):73-9.
18. Sun AY, Chen YM. Oxidative stress and neurodegenerative disorders. *J Biomed Sci* 1998;5(6):401-14.
19. Trimmel M, Schweiger E. Effects of ELF (50HZ, 1mT) electromagnetic field (EMF) on concentration in visual attention, perception and memory including effects of EMF sensitivity. *Toxicol Lett* 1998;96-97:377-82.
20. Sienkiwicz ZJ, Haylock RG, Saunders RD. Deficits in spatial learning after exposure of mice to a 50 Hz magnetic field. *Bioelectromagnetics* 1998;19(2):79-84.
21. Liu T, Wang S, He L, Ye K. Chronic exposure to low intensity magnetic field improves acquisition and maintenance of memory. *Neuroreport* 2008;19(5):549-52.

22. Lai H, Carino MA, Ushijima I, Sajadi AA, Sadeghi H, Taherian AA. Acute exposure to a 60 Hz magnetic field affects rat's water maze performance. *Bioelectromagnetics* 1998;19(2):117-22.
23. Jadidi M, Firoozabadi M, Rashidy-Pour A, Sajadi AA, Sadeghi H, Taherian AA. Acute exposure to a 50 Hz magnetic field impairs consolidation of spatial memory in rats. *Neurobiol Learn Mem* 2007;88(4):387-92.
24. Kabuto H, Yokoi I, Mori A, Ogawa N. Effects of an in vivo 60 Hz magnetic field on monoamine levels in mouse brain. *Pathophysiology* 2000;7(2):115-19.
25. Manikonda P, Rajendra P, Devendranath D, et al. Influence of extremely low frequency magnetic fields on Ca signaling and NMDA receptor functions in rat hippocampus. *Neurosci Lett* 2007;413(2):145-9.
26. Lei Y, Liu T, Wilson FA, Zhou D, Ma Y, Hu X. Effects of extremely low frequency electromagnetic fields on morphine-induced conditioned place preferences in rats. *Neurosci Lett* 2005;390(2):72-5.
27. Aronsson P, Liljenstrom H. Non-Synaptic modulation of cortical network dynamics. *Neurocomputing* 2000; 32-33:285-90.
28. Whishaw IQ. Dissociating performance and learning deficits on spatial navigation tasks in rats subjected to cholinergic muscarinic blockade. *Brain Res Bull* 1989;23(4-5):347-58.
29. McGaugh JL. Memory--a century of consolidation. *Science* 2000;287(5451):248-51.
30. Lai H, Singh NP. Acute exposure to a 60 Hz magnetic field increases DNA strand breaks in rat brain cells. *Bioelectromagnetics* 1997;18(2):156-65.
31. Lai H, Singh NP. Magnetic field induced DNA strand breaks in brain cells of the rat. *Environ Health Perspect* 2004; 112(6):687-94.